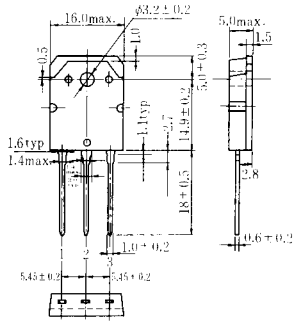
2SD1466

シリコン NPN 三重拡散形

高電圧大電力スイッチング用

SILICON NPN EPITAXIAL

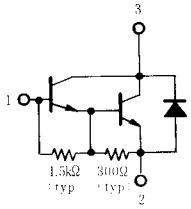
HIGH VOLTAGE HIGH POWER SWITCHING



(TO-3P)

1. ベース:Base
2. エミッタ:Emitter
3. コレクタ:Collector

(Dimensions in mm)



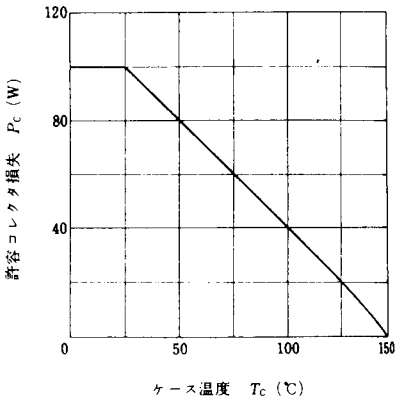
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SD1466	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	450	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	15	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	30	A
ベース電流	I_B	3	A
許容コレクタ損失	P_C*	100	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	℃

* Tc=25℃における許容値。
* Value at Tc=25℃

許容コレクタ損失のケース温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=0.1mA, I_E=0	500	−	−	V
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEO(sus)}$	I_C=5A, R_{BE}=∞	450	−	−	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=100mA, I_C=0	7	−	−	V
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	V_{CE}=400V, I_C=0	−	−	50	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	V_{CE}=3V, I_C=15A	200	−	−	
直流電流増幅率	h_{FE2}	V_{CE}=3V, I_C=8A	50	−	−	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=12A, I_B=0.24A	−	−	2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$		−	−	2.5	V
ターンオン時間	t_{on}	I_C=15A, I_{B1}=−I_{B2}=0.3A	−	1.5	3.0	μs
蓄積時間	t_{stg}		−	4.0	12.0	μs
下降時間	t_f		−	3.0	6.0	μs

■ 各特性曲線は2SD1203参照。

See characteristic curves of 2SD1203.